

嵌入式解決方案



PCIe M.2 SSDs

MTE652T2

創見MTE652T2固態硬碟搭載PCIe Gen 3 x4介面，符合NVMe 1.3規範，展現前所未有的傳輸效能。採用最新一代3D快閃記憶體，大幅突破單位密度上限，打造高儲存效益。30μ"金手指厚金鍍層PCB及緣補強技術(Corner Bond)提供絕佳耐用性，並內建DRAM快取記憶體，加快隨機存取速度。此外，MTE652T2固態硬碟具備類寬溫(-20°C ~ 75°C)特性，賦予其抗熱耐寒表現，並具備3K抹寫次數的耐用度等級。

硬體特點

- 內建DDR3 DRAM快取記憶體
- 耐用度為3K次抹寫週期 (P/E cycles)
- 30μ"金手指厚金鍍金工藝
- 支援於類寬溫條件(-20°C到75°C)下運作
- 全系列產品搭載邊緣補強技術(Corner Bond)，保護關鍵元件

訂購資訊

64GB	TS64GMTE652T2
128GB	TS128GMTE652T2
256GB	TS256GMTE652T2
512GB	TS512GMTE652T2

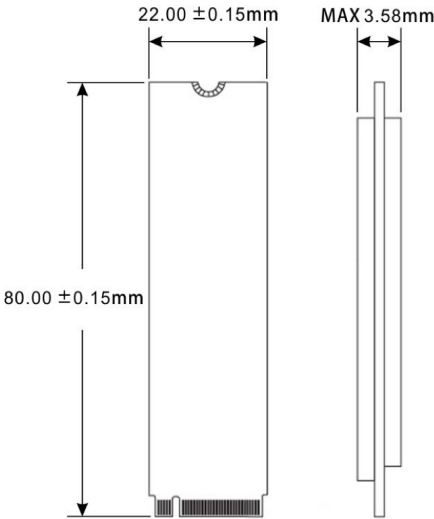
韌體特點

- 支援NVM指令
- 內建LDPC ECC自動糾錯功能
- 動態熱能管理機制
- 支援全區平均抹寫及故障區塊管理，增加可靠性
- 支援垃圾資料回收機制

規格

外觀	尺寸	80 mm x 22 mm x 3.58 mm (3.15" x 0.87" x 0.14")
	重量	9 g (0.32 oz)
	外觀尺寸	M.2
	M.2規格	2280-D2-M (雙面打件)
介面	匯流排介面	NVMe PCIe Gen3 x4
存儲	Flash類型	3D快閃記憶體
	容量	64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB
操作環境	工作電壓	3.3V±5%
	工作溫度	類寬溫 -20°C (-4°F) ~ 75°C (167°F)
	儲存溫度	-55°C (-67°F) ~ 85°C (185°F)
	濕度	5% ~ 95%
	耐衝擊	1500 G, 0.5 ms, 3 axis
	耐振動 (靜止)	20 G (peak-to-peak), 7 Hz ~ 2000 Hz (frequency)
電量	耗電量 (操作中)	3.3 瓦
	耗電量 ((IDLE)	0.6 瓦
效能	連續讀寫速度 (CrystalDiskMark)	讀取: 高達 2,100 MB/s 寫入: 高達 1,000 MB/s
	4K隨機讀寫速度 (IOmeter)	讀取: 高達 190,000 IOPS 寫入: 高達 290,000 IOPS
	平均故障間隔 (MTBF)	3,000,000 小時
	寫入兆位元組 (TBW)	高達 1,080 TBW
	每日全碟寫入次數 (DWPD)	2 (3 年)
保固	安規認證	CE / FCC / BSMI
	保固	三年有限保固

機構尺寸



產品規格如有變更，恕不另行通知。外觀圖片僅供參考，請以實際產品為準。總可用容量會因操作環境而異。由於工業應用的多元性及複雜性，創見無法保證本產品完全相容於所有平台與使用情境。如有特殊需求及操作環境，建議您購買前先與我們聯繫。